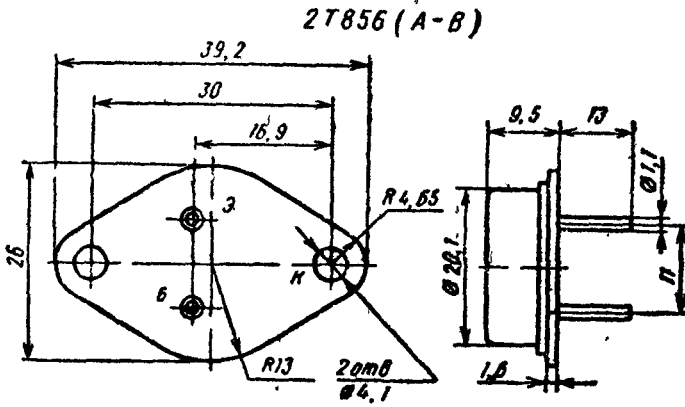


2Т856 (А, Б, В)

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры *n-p-n* переключательные. Предназначены для применения в переключающих устройствах. Корпус металлический со стеклянными изоляторами и жесткими выводами. Масса транзистора не более 16 г



Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при $U_{КЭ} = 5 \text{ В}$, $I_K = 5 \text{ А}$:

$T_K = +25^\circ\text{C}$:	
2Т856А	10...30
2Т856Б, 2Т856В	10...60
$T_K = +125^\circ\text{C}$:	
2Т856А	5...30
2Т856Б, 2Т856В	5...60
$T_K = -60^\circ\text{C}$:	
2Т856А	5...60
2Т856Б, 2Т856В	5...100

Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме ОЭ при $U_{КЭ} = 10 \text{ В}$, $I_K = 2 \text{ А}$, не менее типовое значение

Граничное напряжение при $I_K = 0,1 \text{ А}$, не менее:

$T_K = +25$ и -60°C :	
2Т856А	450 В
2Т856Б	400 В
2Т856В	300 В
$T_K = +125^\circ\text{C}$:	
2Т856А	400 В
2Т856Б	350 В
2Т856В	250 В

Напряжение насыщения коллектор — эмиттер при $I_K = 5 \text{ А}$, $I_B = 1 \text{ А}$

Напряжение насыщения база — эмиттер при $I_K = 5 \text{ А}$, $I_B = 1 \text{ А}$

Время включения при $U_K = 200 \text{ В}$, $I_K = 5 \text{ А}$, $I_B = 0,5 \text{ А}$

Время спада при $U_K = 200 \text{ В}$, $I_K = 5 \text{ А}$, $I_B = 0,5 \text{ А}$, не более

Время рассасывания при $U_K = 200 \text{ В}$, $I_K = 5 \text{ А}$, $I_B = 0,5 \text{ А}$, не более

Обратный ток коллектора, не более:

$T_K = +25^\circ\text{C}$, $U_{КЭ} = U_{КЭ, \text{макс}}$	3 мА
$T_K = +75$ + 125°C и -40 ... -60°C , $U_{КЭ} = 800 \text{ В}$ для 2Т856А, 650 В для 2Т856Б, 500 В для 2Т856В	5 мА

Обратный ток эмиттера при $U_{ЭБ} = 5 \text{ В}$, не более

Емкость коллекторного перехода при $U_{КЭ} = 90 \text{ В}$, $f = 0,3$... 1 МГц , не более

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор — база¹ при $T_K = -40$... $+75^\circ\text{C}$.

2Т856А	1000 В
2Т856Б	800 В
2Т856В	600 В

Постоянное и импульсное² напряжение коллектор — эмиттер при $R_{ЭЭ} = 10 \text{ Ом}$:

2Т856А	950 В
2Т856Б	750 В
2Т856В	550 В

Постоянное напряжение эмиттер — база

Постоянный ток коллектора

Импульсный ток коллектора

Постоянный ток базы

Постоянная рассеиваемая мощность³ при $U_{КЭ} \leq 40 \text{ В}$:

$T_K = +25^\circ\text{C}$	75 Вт
$T_K = +125^\circ\text{C}$	15 Вт

Тепловое сопротивление переход — корпус

Температура *p-n* перехода

Температура окружающей среды

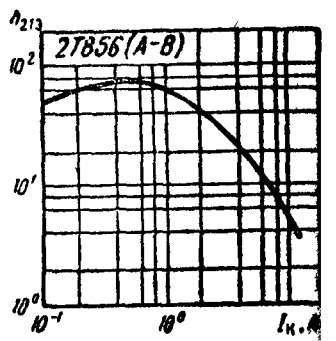
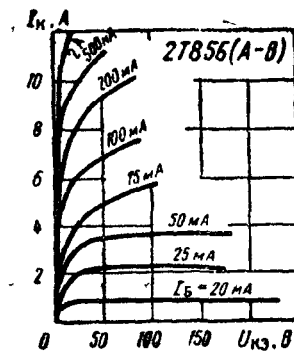
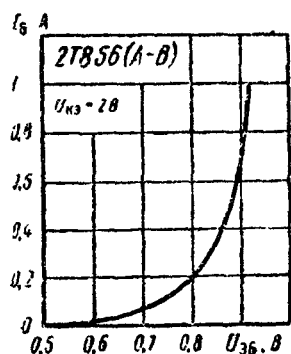
	1,67 °C/Вт
	+150 °C
	-60 °C... $T_K = +125^\circ\text{C}$

¹ При $T_K = -40$... -60°C и $T_K = +75$... $+125^\circ\text{C}$ $U_{КЭ, \text{макс}}$ снижается линейно до 800 В для 2Т856А, 650 В для 2Т856Б, 500 В для 2Т856В.

² Для одиночного импульса при $t_{\text{имп}} > 1 \text{ мкс}$. При $t_{\text{имп}} \leq 1 \text{ мкс}$

$$U_{КЭВ} \text{ и } I_{К, \text{макс}} = U_{КЭЭ, \text{эр}}$$

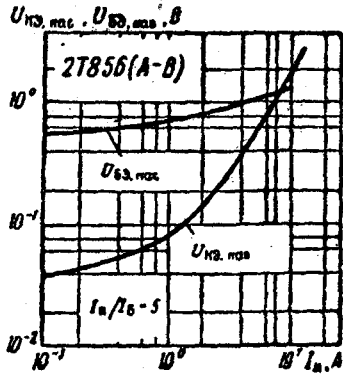
³ При $T_K = +25$... $+125^\circ\text{C}$ $P_{К, \text{макс}}$ уменьшается линейно.



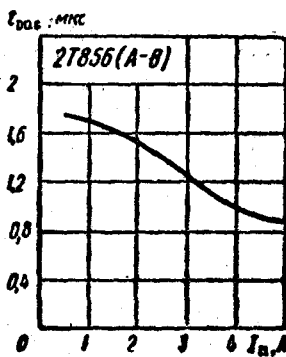
Входная характеристика

Выходные характеристики

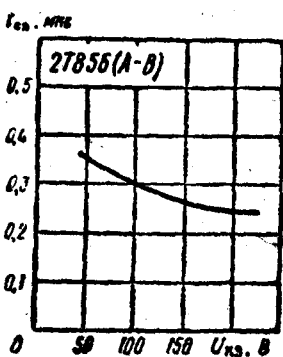
Зависимость статического коэффициента передачи тока от тока коллектора



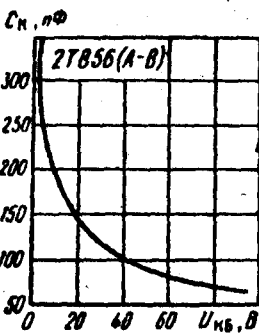
Зависимости напряжений насыщения коллектор — эмиттер и база — эмиттер от тока коллектора



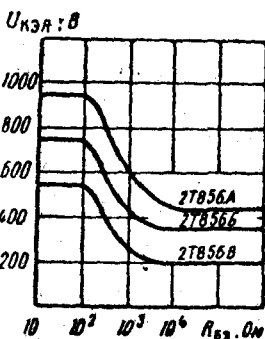
Зависимость времени рассеивания от тока коллектора



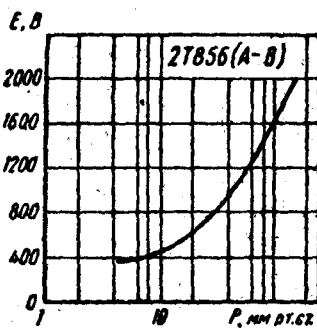
Зависимость времени спада от напряжения коллектор — эмиттер



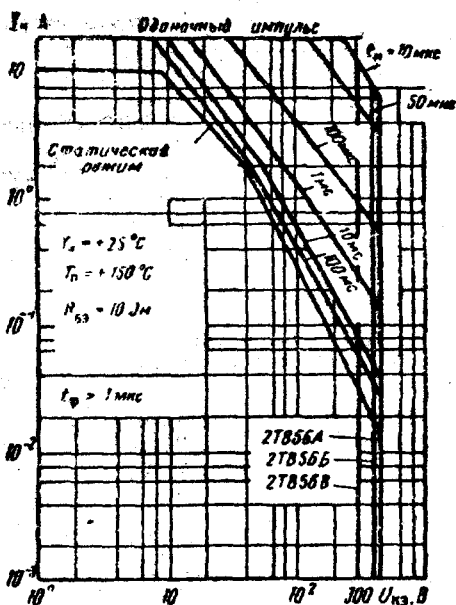
Зависимость емкости коллекторного перехода от напряжения коллектор — база



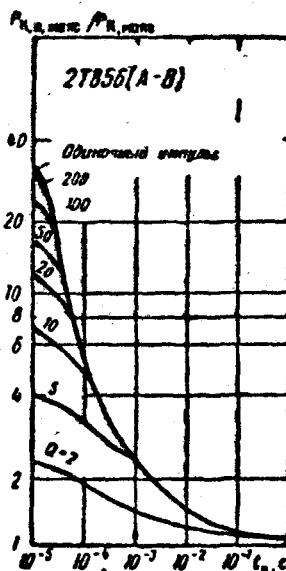
Зависимости постоянно напряжения коллектор — эмиттер от сопротивления база — эмиттер



Зависимость электрической прочности воздушных промежутков между выводами базы и коллектора



Области максимальных режимов



Зависимости максимально допустимой импульсной рассеиваемой мощности коллектора от длительности импульса